# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-021637

(43) Date of publication of application: 24.01.1992

(51)Int.CI.

A61K 47/36 B01J 20/26 CO8B 37/08 GO1N 30/48 G01N 33/543

GO1N 33/548

(21)Application number: 02-122459

(22)Date of filing:

11.05.1990

(71)Applicant: SOKEN KAGAKU KK

(72)Inventor: MORIKAWA SHUNICHI

HANADA KATSUHIRO TAKEMOTO KIYOTAKA

ARAI TAKAAKI

# (54) HIGH POLYMER FINE GRAIN WHOSE SURFACE IS MODIFIED WITH CHITIN DERIVATIVE OR CHITOSAN AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain high polymer fine grains having a hydrophilic and positively ionized surface and improved in affinity to a biological high polymer by modifying the surface of high polymer fine grains with a chitin derivative or chitosan.

CONSTITUTION: High polymer fine grains having an active groups reactive with a carbodiimide compound, preferably a carboxyl latex having 0.2-10µm grain size is made to react with a compound expressed by the formula RN=C= NR' (R is ethyl and R' is dimethylaminopropyl or R and R' are cyclohexyl together) at ordinary temperature and successively subjected to a reaction with a chitin derivative (preferably diethylaminoethylchitin) or chitosan added at ordinary temperature. The resultant modified high polymer fine grains are used as a latex for immobilization of bioaffinitive ingredient, physiologically active substance and medicine, etc., latex for immunodiagnostic agent and endotoxin removing agent.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-21637

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月24日

A 61 K 47/36 20/26 B 01 J

B 7624-4C L

2104-4G 2104-4G\* Ħ

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全4頁)

9発明の名称

キチン誘導体又はキトサンを表面に修飾した高分子微粒子並びにそ の製造方法

> 題 平2-122459 创特

願 平2(1990)5月11日 22出

個発 明 者 111 森

俊

埼玉県新座市栗原2-4-39

饱発 明 老 걘  $\mathbf{H}$ 明

克 裕

埼玉県入間市仏子603-1 32-704号

@発 老 竹 本

濟 孝 埼玉県狭山市入間川2-24-27

個発 明 者 井 新

孝 昭 埼玉県草加市谷塚町1203

人 四代 理 弁理士 佐田

綜研化学株式会社 守雄 東京都豊島区高田3丁目29番5号

外2名

最終頁に続く

願

创出

#### 1. 発明の名称

キチン誘導体又はキトサンを表面に修飾 した高分子微粒子並びにその製造方法

### 2. 特許請求の範囲

- 1. キチン誘導体又はキトサンを表面に修飾し た高分子微粒子。
- 1. キチン誘導体がジェチルアミノエチルキチ ンである請求項1記載の高分子微粒子。
- 1. 高分子微粒子がカルボキシルラテックスで ある請求項1記載の高分子微粒子。
- 4. カルポキシルラテックス微粒子に式RN=C =NR'(式中Rはエチル基、R'はジメチルア ミノブロピル基又はR、R'は共にシクロへ キシル基を示す)を有するカルポジイミド化 合物を反応させ、次いでキチン講導体又はキ トサンを反応させることを特徴とするキチン 誘導体又はキトサンを表面に修飾した高分子 徴粒子の製造方法。
- キチン誘導体がジェチルアミノエチルキチ

ンである請求項4記載の高分子微粒子の製法。

# 3. 発明の詳細な説明

### 〔産業上の利用分野〕

本発明は、蛋白質、核酸等の生体成分の分 雕精製に使用されるクロマトグラフィーの吸 着材、ドラッグ・デリバリー・システム用担 特体、免疫診断用ラテックスなどに有用なキ チン質又はキトサンを表面に修飾させた高分 子微粒子並びにその製造方法に関する。

#### (従来の技術)

従来、抗原抗体反応を利用した免疫学的 臨床検査診断薬に疎水性表面を有するポリ スチレンラテックスが用いられている (). Colloid EnterfaceSci., 71, 350 (1979) . しかし、ポリスチレンラテックスは破水性で あるため、感作安定性、保存安定性が欠ける ため、球水性を改質するためスチレンにメタ クリル酸等を共重合させた微粒子高分子の研 究、開発も行われている。

### (発明が解決しようとする課題)

上記スチレンラテックスにおいては、感作と性、保存安定性に欠け、またメダククスを対象を共盛合させたスチレン系ラテックスないでは、保存安定性が十分でないばかりでなく、これらスチレン系ラテックスは抗体を固定化した免疫学的血清、血漿、尿等の高感度、定量分析用ラテックスとしては満足するものではない。

本発明はラテックスを観水性に改良し、更に好適には正荷電性へ変換させて動物細胞、免疫蛋白質等の生体高分子に対する観和性を免疫蛋白質、核酸等の生体成分に特異的な吸着性を有し、ドラッグ・デリバリー・等はステム用担待体、免疫診断用ラテックスととでものである。

#### [課題を解決するための手段]

本発明等はパイオアフィニティー成分、生

導体又はキトサンを反応させることを特徴と するキチン誘導体又はキトサンを表面に修飾 した高分子微粒子の製造方法である。

本発明に使用する高分子微粒子はカルボジイミド化合物と反応する活性基を有する高分子化合物であり、カルボキシルラテックスが好適である。そしてその粒径は製品の用途により適宜選択されるが、大体0.2~10μmが普通使用される。

この高分子微粒子に経飾されるキチン誘導体としては、水溶性のキチン誘導体、例えば、ジェチルアミノエチルキチン、カルポキシメチルキチン、ヒドロキシブロビルキチン、ヒドロキシエチルキチン、硫酸エステルキチン、リン酸エステルキチン、硫酸エステルキチン、リン酸エステルキチン等が好適に用いられ、本発明者等が先に発表したジエチルアミノエチルキチン(Polymer Bulletin. 21、13-17(1989))が最も適している。キトサンもキチンを脱アセチル化したものでキチンの構成単位であるグルコサミンを有し、しかも正電

本発明は、キチン誘導体又はキトサンを表 面に修飾した高分子微粒子である。そしてカ ルポキシルラテックス微粒子を式

RN=C=NR'(式中Rはエチル基、R'はジメ チルアミノプロピル基又はR, R'は共にシ クロヘキシル基を示す)で表わされるカルポ ジイミド化合物と反応させ、次いでキチン誘

荷を有する物質であり、本発明に好適に適用できる。

上記キチン酵車体又はキトサンを有する高分子微粒子を製造するには、カルポキシル基などの活性基を有する高分子微粒子、好適にはカルポキシルラテックス、この物質は例え

### 特別平4-21637(3)

ば、スチレンモノマーを単独で重合させ核粒子とした後、アクリルアミドを添加し、2段重合法により精製したスチレン-アクリルアミド共重合ラテックスを加水分解することにより得られる。

この高分子微粒子に水を媒体として水溶性の一般式 RN=C=NR' (式中、R, R'は前配と同一意義を有す。)で表わされるカルボジイミド化合物、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド・1,3-ジシクロヘキシルカルボジイミドを常温で反応させ、次にチキン誘導体又はキトサンを加え約12時間位常温で反応すると本発明のキチン誘導体又はキトサンを表面に修飾した高分子微粒子が得られる。

本方法におけるキチン誘導体及びキトサンの使用量は高分子のカルポキシル基に対し、キチン誘導体又はキトサンのアミノ基として1~8倍モル量が適当であり、4~8倍モル量が好適である。又、水溶性カルポジイミド

圧乾燥しジェチルアミノエチルキチン修飾
ラテックス0.68gを得た。このものの表面
荷電量は24.6μ当量/g・ラテックスであった。また、得られたラテックスの接触角
(θ)は26.4であった。なお表面荷電量はコーロイド満定により測定し、接触角は自動式
PHT型接触角針で測定した。

#### 例 2 ~ 3

1-エチル-3-(3-ジメチルアミノブロビル)カルボジイミド塩酸塩(TSC)及び1%ジエチルアミノエチルキチン水溶液(DEAE-キチン水溶液)を第1表に示す量加えた以外は例1と同様の操作を行い、DEAE-キチン体飾ラテックスを得た。この例の収量、表面荷電量及び接触角は第1表の通りであった。なお、1%DEAE-キチン量はラテックス中のカルボキシル基に対してDEAE-キチンのアミノ基として4倍乃至8倍モル量である。

化合物の使用量は、キチン誘導体又はキトサンのアミノ基に対し0.5~1.5倍モル量が適当であり、好適には0.8~1.2倍モル量である。

次に本発明の微粒子の製造法並びに得られた物質の性質を記載する。

#### 〔寒 施 例〕

#### 例 1

表面電荷量89.5 μ 当量/g・ラデックス、 粒径0.6 μm、比表面積10 ㎡/g・ラデックス のカルボキシルラテックスの分散被(濃度 0.0157 g/m2)400 m2に1-エチル・3~(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド 塩酸塩0.0108 g を加え、室温で2時間撹拌 する。次いで1%ジエチルアミノエチルキ チン水溶液63 g(ラテックス中のカルボキ シル基に対してジエチルアミノエチルキチ ンのアミノ基として2倍モル量)を加え、 12時間反応させ、次いで2 M酢酸緩衝液 (PH=4)を加えて2時間撹拌し得られた 生成物をip別する。その後水で洗浄し、減

第 1 表 .

実施例	WSC	1 % DEAE- キチン水溶液 (g)		表面荷電量 (μ当量/g・ (ラテックス)	接触角 (8)
2	0.0216	12.8	0, 50	152,8	28.7
3	0,0432	25.2	0, 70	142, 2	40. Z

### 例 4 ~ 6

1%DEAE-キチン水溶液を1%キトサン水溶液に代え、ISC及び1%キトサン水溶液に代え、ISC及び1%キトサン水溶液量を第2数に示す量を加えた以外は実施例1と同様の操作を行い、キトサン修飾ラテックスを得た。この例の収量、表面荷電量及び接触角は第2表の通りであった。なお、1%キトサン水溶液量はラテックス中のカルボキシル基に対してキトサンのアミノ基として2倍乃至8倍モル量である。

以下余白

#### 焦 2 澄

実施例	WSC	1%キトサン 水 溶 液 (g)	収 <u>素</u> (g)	表面荷電量 (μ当量/g・) ラテックス)	接触角 (8)
4	0,0108	2.4	1.03	12.6	-
5	0.0216	4.8	0,60	20.7	46.0
6	0.0432	9, 6	0,60	28.6	61.0

#### 49d 7

表面荷電量38.5μ当量/8・ラテックス、 満度0.0175g/mgのカルポキシルラテック ス水分散液40mgを用い、TSC 0.0052g、 1 %DEAE-キチン水溶液3.0g (ラテックス中 のカルポキシル基に対してDEAE-キチンの アミノ基として 2 倍モル量)加えた以外は、 実施例1 と同様の操作を行い、DEAE-キチン というデックス0.81gを得た。このもの の表面荷電量は21.6μ当量/g・ラテック スであった。

#### **54** 8

1%DEAE-キチン水溶液を1%キトサン水溶液1.1g(ラテックス中のカルボキシル基に対してキトサンのアミノ基として2倍モル量)に代えた以外は、例7と同様の操作を行い、キトサン修飾ラテックス0.97gを得た。このものの表面荷電量は4.3μ当量/g・ラテックスであった。

## 〔発明の効果〕

本発明は微粒子上に親水性好ましくは更にで荷電をも有するキチンの構成単体を持つ物質を修飾した微粒子であり、これにより生体高分子に対する特異の親和性を有するためパイオアフィニティー成分、生理活性物質、薬利などの固定、免疫診断薬用ラテックス、エンドトキシン除去剤として極めて広範囲の用途を有する物質を提供する有用な発明である。

等 出 顧 人 蒜 研 化 学 株 式 (字) 代理人 并理士 佐 田 守 雄 (外

### 第1頁の続き

⑤Int. Cl.	5	識別記号		<b>宁内整理番号</b>
C 08 B C 08 F C 08 J G 01 N	37/08 8/30 3/12 30/48 33/543 33/548	MHA	A Z P U Q B	7624-4C 8016-4J 7918-4F 7621-2J 7621-2J 7906-2J 7906-2J